



## Conditions d'acceptation en 1<sup>ère</sup> année Doctorat Commission en Electronique et Microélectronique de l'ENIS

Par suite des 2 Procès-Verbaux de la Commission des Thèses en EμE de l'ENIS du 23 Novembre 2020 et du 25 Avril 2022 :

### - Pour les candidats Ingénieurs

M1 : Moyenne de la première année GE

M2 : Moyenne de la deuxième année GE

M3 : Moyenne de la troisième année GE sans PFE où

$M3 = 0.5 [3x \text{ Moyenne de la troisième année} - \text{Note du PFE}]$

N : Nombre de redoublements (cycles préparatoire et d'application)

$$\text{Score 1} = (M1 + M2 + M3 - N) \geq 34$$

### - Pour les candidats Ingénieurs issus des établissements privés

$$\text{Score 2} = (M1 + M2 + M3 - N) \geq 39$$

### - Pour les candidats titulaires d'une Licence et d'un Master

M1 : Moyenne de la première année de la Licence

M2 : Moyenne de la deuxième année de la Licence

M3 : Moyenne de la troisième année de la Licence, sans PFE

M4 : Moyenne de la première année du Master

M5 : Moyenne de la deuxième année du Master, sans PFE

N : Nombre de redoublements (Licence et Master)

$$\text{Score 3} = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 - N) \geq 57$$

### - Pour les candidats titulaires Licence et Master issus d'établissements privés

$$\text{Score 4} = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 - N) \geq 65$$

### - Pour les candidats étrangers : chaque dossier sera étudié à part.